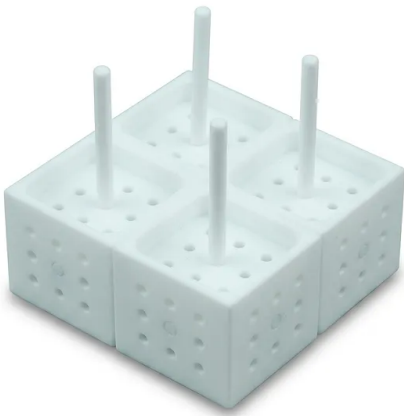


Cesta De Limpieza De Obleas De Ptfе Personalizada, Portador De Fluoropolímero Resistente A Productos Químicos Para Grabado De Semiconductores Y Procesamiento De Nuevas Energías

Número de artículo: PL-CP149



Introducción

Optimice su fabricación de semiconductores y nuevas energías con cestas de limpieza de obleas de PTFE personalizadas. Diseñados para una resistencia química extrema durante el grabado y la limpieza RCA, estos portadores de fluoropolímero de alta pureza garantizan la integridad del proceso y una durabilidad a largo plazo en entornos industriales exigentes.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Limpieza RCA de Semiconductores	Limpieza secuencial de obleas de silicio con soluciones SC-1 y SC-2 para eliminar contaminantes orgánicos y metálicos.	Cero contaminación y resistencia a mezclas de amoníaco/peróxido.
Grabado con Ácido Fluorhídrico (HF)	Eliminación de óxidos nativos o grabado controlado de capas de dióxido de silicio en superficies de obleas.	Resistencia absoluta al HF, que disolvería alternativas de vidrio o cuarzo.
Texturizado Fotovoltaico	Grabado químico húmedo de obleas de silicio monocristalino o policristalino para crear superficies de captación de luz.	La alineación uniforme de ranuras garantiza un texturizado uniforme en lotes grandes.
Procesamiento con Solución Piraña	Eliminación agresiva de residuos orgánicos y fotorresistencia utilizando ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno.	Soporta reacciones exotérmicas extremas y acidez a alta temperatura.
Enjuague Post-CMP	Limpieza crítica de obleas después del pulido químico-mecánico para eliminar pastas abrasivas.	Superficies lisas y alto drenaje evitan la redeposición de partículas.
Preparación de Semiconductores Compuestos	Limpieza especializada de obleas de GaAs o InP para fabricación avanzada de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos.	Geometría de ranura personalizable para espesores y tamaños de oblea no estándar.
Carga de Reactores de Microcanal	Posicionamiento de sustratos dentro de cámaras de reacción personalizadas para deposición controlada en fase de vapor o líquida química.	Dimensiones adaptadas permiten un ajuste perfecto en configuraciones de laboratorio a medida.
Desarrollo de Litografía	Sujeción de sustratos durante el revelado y eliminación de capas de fotorresistencia en flujos de trabajo de microfabricación.	La resistencia a disolventes garantiza que el portador no se degrade ni desprenda gases durante el proceso.

Parámetro	Detalle de Especificación para PL-CP149
Identificador de Modelo	Serie PL-CP149
Construcción del Material	100% PTFE (Politetrafluoroetileno) Virgen de Alta Pureza
Método de Fabricación	Mecanizado CNC Totalmente Personalizado
Compatibilidad Química	Universal (Ácidos, Bases, Disolventes, Oxidantes, HF)
Rango de Temperatura de Operación	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Compatibilidad con Obleas	Personalizable para tamaños de 2", 3", 4", 6", 8", 12" o no estándar

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Parámetro	Detalle de Especificación para PL-CP149	
Configuración de Ranuras	Totalmente Personalizable (Paso, ancho y profundidad variables)	
Número de Ranuras	Definido según requerimiento del cliente (ej: capacidad de 10, 25, 50)	
Diseño del Mango	Integrado, Desmontable o Extendido (Longitud personalizable)	
Acabado de Superficie	Acabado mecanizado liso y de baja porosidad	
Estándar de Pureza	Apto para Análisis de Trazas y uso en Salas Limpias Clase 10/100	
Características de Drenaje	Puertos de drenaje inferiores/laterales personalizables	